

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 พนฐาน	11
2.1 ทฤษฎีแบบพลังงานของสารกึ่งตัวนำ	11
2.2 ลักษณะสมบัติของสารกึ่งตัวนำที่มีค่าแสง	20
2.3 องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดลักษณะสมบัติของการเคลื่อนที่ของพาหะนำไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์	24
2.4 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์	27
2.5 ลักษณะสมบัติและพารามิเตอร์ที่สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์	29
2.6 กระแสโฟโตของเซลล์แสงอาทิตย์ (I_{ph}) และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	34
2.7 วงจรสมมูล์ของเซลล์แสงอาทิตย์	37
2.8 ความอุดมสมบูรณ์ของวัสดุที่จะใช้ทำเซลล์แสงอาทิตย์	39
บทที่ 3 เซลล์แสงอาทิตย์ชิลิกอน	41
3.1 เทคโนโลยีชิลิกอน	42
3.2 เทคโนโลยีชิลิกอนแบบพลาสติก	52
3.3 เซลล์แสงอาทิตย์แบบหัวต่อพีโอน	68

3.4 เชลแสงอาทิตย์ชิลิกอนแบบชั้อตคิเบเรีย	74
3.5 เชลแสงอาทิตย์แบบ MIS (Metal–Insulator–Semiconductor)	80
3.6 Back Surface Field (BSF)	83
3.7 Texturization	85
บทที่ 4 เชลแสงอาทิตย์ชิลิกอนแบบ Polycrystalline	88
4.1 อิทธิพลของ Grain Boundary	89
4.2 การสร้างเชลแสงอาทิตย์จาก Polycrystalline ที่มีโครงสร้างแบบ Fibrous Orientation	91
4.3 การสร้างเชลแสงอาทิตย์จาก Ribbon Silicon	92
4.4 เชลแสงอาทิตย์แบบพื้นบางที่ทำจาก Polycrystalline	96
บทที่ 5 เชลแสงอาทิตย์ที่ทำจาก omniphotovoltaic	98
5.1 Glow Discharge Deposition	99
5.2 RF Sputtering Method	104
5.3 Hydrogenation Effect	105
5.4 คุณสมบัติทางค้านสารของ α -Si	107
5.5 การใช้งานของเชลแสงอาทิตย์แบบ omniphotovoltaic	109
บทที่ 6 เทคโนโลยีเหมาะสมสำหรับเชลแสงอาทิตย์ที่ทำจากชิลิกอน	113
6.1 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับเชลแสงอาทิตย์ที่ทำจากชิลิกอน	114
6.2 การใช้แวนเพล็กซิลิกอนแบบขั้ดหยาบเป็นวัสดุเริ่มต้นในการทำเชลแสงอาทิตย์	116

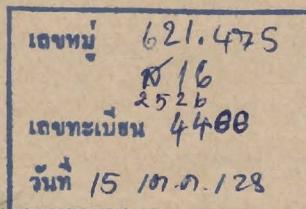
	หน้า
6.3 Anodic Oxidation	118
6.4 Paint-on Diffusion	121
6.5 Chemical Vapor Deposition	125
6.6 Nickel Electroless Plating	136
6.7 Lift-off Metallization	139
6.8 Laser Annealing	141
6.9 การใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์กับแสงความเข้มสูง	149
บทที่ 7 เซลล์แสงอาทิตย์แก้เลี่ยมอาเซนายน้ำ	153
7.1 Liquid Phase Epitaxy (LPE)	154
7.2 Molecular Beam Epitaxy (MBE)	156
7.3 $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}-\text{GaAs}$ Heterojunction Solar Cell	158
7.4 Multilayer $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}-\text{GaAs}$ Heterojunction Solar Cell	161
7.5 Graded Band-gap $\text{GaAlAs}-\text{GaAs}$ Solar Cell	163
7.6 Peeled Film Technology	166
7.7 Thin Film GaAs Solar Cell	168
7.8 การใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์แก้เลี่ยมอาเซนายน้ำ	169
7.9 สรุป	170
บทที่ 8 เซลล์แสงอาทิตย์แบบอื่น ๆ	172
8.1 $\text{Cu}_2\text{S}/\text{CdS}$ Solar Cell	172
8.2 InP Solar Cell	178

	หน้า
8.3 CdTe Solar Cell	180
8.4 สรุป	180
บทที่ 9 การออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์	182
9.1 Encapsulation Technique	183
9.2 การต่อเซลล์แสงอาทิตย์แบบข้างหนานและแบบอนุกรม	186
9.3 ระบบโฟโต voltaic	189
9.4 เงื่อนไขที่ใช้พิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งระบบ โฟโต voltaic	193
9.5 การทดสอบแบงเซลล์แสงอาทิตย์และการเติ่มคุณภาพของ แบงเซลล์แสงอาทิตย์	194
9.6 Thermo-Photovoltaic Hybrid System	195
9.7 ระบบรวมแสงสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์	197
9.8 ตัวรวมแสงแบบต่าง ๆ	199
9.9 สรุป	205
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้งานของระบบโฟโต voltaic และข้อพิจารณาที่ เกี่ยวข้อง	206
10.1 การใช้ระบบโฟโต voltaic ในการบังคับการผู้กร่อนของท่อ ส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ	208
10.2 การใช้ระบบโฟโต voltaic สำหรับการพัฒนาชนบทที่อยู่ห่าง ไกล	211
10.3 การใช้ระบบโฟโต voltaic สำหรับหน่วยงานเคลื่อนที่	214

หน้า

10.4 ราคากันทุนการผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์และระบบ ไฟโตโวต้าอิค	216
10.5 อายุใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์และระบบไฟโตโวต้าอิค	225
10.6 ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์และระบบไฟโตโวต้าอิค	231
บทที่ 11 การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ในทางอุตสาหกรรมและ ทัวอย่างการประยุกต์ใช้งานที่ติดตั้งแล้ว	235
11.1 เทคนิคการเตรียมแวนชิลิกอน	235
11.2 เทคนิคการทำเซลล์แสงอาทิตย์และโมดูล	241
11.3 การทดสอบคุณภาพก่อนประยุกต์ใช้งาน	243
11.4 ทัวอย่างการประยุกต์ใช้งานที่ติดตั้งแล้ว	244
บทที่ 12 บทสรุป	248
เอกสารอ้างอิง	252

เทคโนโลยีชลแสงอาทิตย์



สมศักดิ์ บัญญาแก้ว

BSTI SCIENCE SERVICE
สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ



1110001488



สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือที่สืบทอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘
เจ้าของคือพิมพ์จุฬาลงกรณ์
ไทย ๒๕๑๘๐๕-๖
เช่นนี้ แสดงถึงว่าเป็นหนังสือ

2526



ห้องสมุดความวิชาการสหบัณฑิการ